

応用物理学会若手チャプター
太陽光エネルギー変換機能材料・デバイス開発研究会
～第6回研究会～ ご案内

1. 日時 2026年3月13日(金)~3月14日(土)
2. 場所・研究会、懇親会、宿泊会場：大学セミナーハウス
〒192-0372 東京都八王子市下柚木 1987-1
・企業見学：株式会社 PXP 本社 次世代光電変換素子の研究開発・製造販売拠点
〒252-0203 神奈川県相模原市 中央区 東淵野辺 4-26-9
3. 主催 応用物理学会若手チャプター 太陽光エネルギー変換機能材料・デバイス開発研究会
4. 参加費 一般、学生：共に無料
5. 宿泊費 一般：10,000円 学生：6,000円
6. 意見交換会費 一般：8,000円 学生：無料

7. プログラム

3月13日(金)

大学セミナーハウス 講堂

13:00~13:30 会場受付

13:30~13:45 開会挨拶 河野 悠 (立命館大学)

参加者自己紹介

13:45~14:15 招待講演 1

浅見 明太 先生 (宮崎大学)

14:15~14:45 招待講演 2

甚野 裕明 様 (宇宙航空研究開発機構/東京大学)

14:45~15:00 休憩

15:00~15:30 招待講演 3

神岡 武文様 (産業技術総合研究所)

15:30~15:45 集合写真撮影

15:45~16:00 休憩 (ポスター貼付)

16:00~17:00 学生によるポスターセッション

17:00~17:10 休憩 (会場を元に戻す)

17:10~18:00 基礎講座

本倉 健 先生 (横浜国立大学)

18：00~18：30 移動

大学セミナーハウスさくら館

18：30~20：00 意見交換会（希望者のみ）

20：00~21：00 フリーディスカッション（希望者のみ）

3月14日(土) 企業見学：株式会社 PXP

8：15~9：30 株式会社 PXP へ移動

*現地参加者は9時30分 JR 古淵駅に集合

10：00~10：30 PXP 殿会社紹介

10：30~11：30 工場見学

11：30~12：00 質疑応答、集合写真撮影、閉会挨拶 加藤 慎也（名古屋工業大学）

12：00~12：30 古淵駅へ移動・解散

8. その他

- ◆ 講演時間：基調講演（40分講演、10分質疑）、招待講演（25分講演、5分質疑）、ポスター発表（60分）です。
- ◆ ポスターサイズはA0サイズです。
- ◆ 想定する若手研究者
太陽光エネルギー変換機能材料・デバイス開発研究会に登録している修士、博士、博士取得後の若手研究者(概ね40歳以下)

ポスターセッション 発表リスト

[P1] テラヘルツ波シリコンアンテナレンズの研究

白川滉基*1, 加藤慎也 1, 名工大 1

[P2] ブリッジマン法で育成した n 型 SnS 単結晶を用いたホモ接合太陽電池の作製

中村薫*1, 鈴木一誓 1, 野上大一 1, 茂田井大輝 1, 小俣孝久 1, 東北大 1

[P3] SnS 薄膜をチャネル層に用いた薄膜トランジスタの作製

工藤温紀*1, 鈴木一誓 1, 野上太一 1, 茂田井大輝 1, 小俣孝久 1, 東北大 1

[P4] Analysis of Theoretical Conversion Efficiency of Quantum-Cutting Luminescent Solar Concentrators (QC-LSCs) using a CsPb(Br_{1-x}Cl_x)₃:Yb₃₊ Luminescent layer

藤本敬太 1*, 宮島晋介 1 東京科学大 1

[P5] ミスト CVD 法を用いた Zn(O, S) 薄膜の作製および Cu(In, Ga)Se₂ 太陽電池への応用

船木顕広*1, 西村昂人 1, 山田明 1, 東京科学大 1

[P6] 硫黄プラズマを活用した結晶性硫化物薄膜の低温形成

茂田井大輝*1, 鈴木一誓 1, 野上大一 1, 小俣孝久 1, 東北大 1

[P7] Indium-Zinc-Oxide(IZO)によるスパッタダメージが性能に与える影響の評価

横田浩亮*1, 峯元高志 1, 立命館大 1

[P8] BaZrS₃を用いたカルコゲナイドペロブスカイト太陽電池における光吸収層の高抵抗改善

小倉宏太*1, 山西美月 1, 河野悠 1, 和田隆博 1, 峯元高志 1, 立命館大 1

[P9] 貼り合わせオールペロブスカイト 2 接合 2 端子太陽電池の作製

伊藤蛍*1, 多田圭志 1, 栗井文康 1, 石川亮佑 2, 内田聡 1, 瀬川浩司 1 東大 1, 都市大 2

[P10] 静電スプレー法を用いた PEDOT:PSS/シリコン太陽電池の開発及びスパッタリング法を用いた ITO (酸化インジウムスズ) 薄膜形成による高効率化

跡見柊斗*1, 村田拓生 1, 加藤慎也 1, 名工大 1

[P11] 静電スプレー法による CsPbI₃ 薄膜の作成

箱田岳*1, 山本昂市 1, 加藤慎也 1, 名工大 1